CORONA DISCHARGE TREATMENT

Patent number:

JP11060759

Publication date:

1999-03-05

Inventor:

YUASA MOTOKAZU: MATSUNAGA KOICHI

Applicant:

SEKISUI CHEMICAL CO LTD; HAIDEN KENKYUSHO

KK

Classification:

- international:

C08J7/00; B01J19/08; C08K3/22; C08L101/00;

B29K105/16; B29L7/00

- european:

Application number: JP19970228520 19970825 Priority number(s): JP19970228520 19970825

Report a data error here

Abstract of **JP11060759**

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method capable of stably carrying out a corona discharge treatment of a substrate such as the substrate having a high electroconductivity, a foam, the substrate having uneven surface and a fluororesin, to which a conventional corona discharge treatment method is hardly applied, at a high speed. SOLUTION: This method for corona discharge treatment comprises causing corona discharge by a high voltage pulse electric field having <=100 &mu s voltage rising time, 1-1000 &mu s pulse duration, 1-100 kHz frequency, and 1-100 kV/cm average electric field strength.

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-60759

(43)公開日 平成11年(1999)3月5日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号		. F I					
CO8J 7/00	303		C08J	7/00		3 (3	
B01J 19/08			B01J	19/08			С	
C08K 3/22			C08K	3/22				
C08L 101/00			C08L	101/00				
// B 2 9 K 105:16				•				
		審查請求	未請求 請	求項の数3	OL	(全	9 頁)	最終頁に続く
(21)出願番号	特顯平9-228520		(71) 出席	貫人 00000	2174			
				積水化	之学工業	株式会	社	
(22)出願日	平成9年(1997)8月25日			大阪府	大阪市	北区	西天湖 2	丁目4番4号
			(71)出題	質人 59313	3693			
				株式会	社ハイ	デンを	开究 所	
	•			兵庫県	明石市	魚住	丁清水46	5の1
			(72)発明	用者 湯浅	基和			
				大阪府	亨三島郡	島本町	丁百山2	番1号 積水化
				学工第	e株式会	社内		
			(72)発明	居者 松永	浩—			
				兵庫県	神戸市	垂水	K南多聞	台2丁目3の9
			(74)代理	型人 弁理士	自合内	義師	男	
	•							
								•

(54) 【発明の名称】 コロナ放電処理方法

(57)【要約】

【課題】 導電性の高い基材、発泡体、凹凸表面を有する基材、フッ素系樹脂等の従来のコロナ処理方法では適用困難であった基材に対しても、高速で安定的にコロナ処理を行うことの出来る方法を提供する。

【解決手段】 電圧立ち上がり時間が 100μ s以下、パルス継続時間が $1\sim1000\mu$ s、周波数 $1\sim100$ kHz、平均電界強度が $1\sim100$ kV/cmの高電圧パルス電界によりコロナ放電を発生させることを特徴とするコロナ放電処理方法。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 電圧立ち上がり時間が 100μ s以下、パルス継続時間が $1\sim1000\mu$ s、周波数 $1\sim100$ kHz、平均電界強度が $1\sim100$ kV/cmの高電圧パルス電界によりコロナ放電を発生させることを特徴とするコロナ放電処理方法。

1

【請求項2】 電圧立ち上がり時間が100μs以下、 パルス継続時間が1~1000μs、周波数1~100 kHzの基本パルス電界を、周波数が50~500Hz であり、かつ、デューティー比が20~70%であるパ 10 ルス電界で変調した、平均電界強度が1~100kV/ cmの高電圧パルス電界によりコロナ放電を発生させる ことを特徴とするコロナ放電処理方法。

【請求項3】 高電圧直流を供給可能な直流電圧供給部、並びに、ターンオン時間及びターンオフ時間が500ns以下である半導体素子により当該高電圧直流をパルスに変換するパルス制御部、から構成される高電圧パルス電源により高電圧パルス電界を印加することを特徴とする請求項1又は2に記載のコロナ放電処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、樹脂フィルムや成型品の塗装性や印刷性等を向上させるために行うコロナ放電処理方法に関する。

[0002]

【従来の技術】ポリプロピレン等のからなる樹脂フィルムの表面にコロナ放電処理を施すことによって、フィルム表面の印刷性や接着性を向上できることは良く知られており、既に実用化されている。しかしながら、導電性の高い基材、低融点の基材、発泡体、細かい凹凸形状のある基材、フッ素系樹脂等は均一に処理し難いという問題点を有している。

【0003】そこで、パルス幅の狭い高電圧パルスを印加するととによって3次元成型品やフッ素樹脂にコロナ放電処理を施す方法が提案されている(特開平4-328135号公報、特開平6-336529号公報、特開平8-198984号公報等)。しかし、処理の安定性、高速化においてはまだ実用レベルにはなく、依然課題があった。

【0004】また、これらの技術はギャップ電極方式のパルス電源を用いているため、パルス頻度は10~1000pps(周波数10Hz~1kHz)であり、これ以上の高速パルスを実現することは出来なかった。そのため、周波数が1kHz以上であるパルス電界によるコロナ放電処理については全く検討されておらず、その効果も明らかにされていなかった。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、上記に鑑み、導電性の高い基材、発泡体、凹凸表面を有する基材、フッ素系樹脂等の従来のコロナ処理方法では適用困

難であった基材に対しても、高速で安定的にコロナ処理 を行うことの出来る方法を提供するものである。

【0006】 【課題を解決するための手段】本発明1のコロナ放電処理方法及び装置は、電圧立ち上がり時間が100μs以下、パルス継続時間が1~100μs、周波数1~10

0kHz、平均電界強度が1~100kV/cmの高電 圧パルスによりコロナ放電を発生させることを特徴とする。

【0007】放電電極及び対向電極の構造は、公知の通常のコロナ放電処理装置の場合と同様で、既知の電極構造が自由に採用できる。例えば、対向電極としては、曲面、平面状の電極が用いられる。対向電極の材質は、銅、アルミ、ステンレス等の金属が用いられる。

【0008】対向電極上の放電電極に向き合う側には、 固体誘電体を介在させる。ポリテトラフルオロエチレン、ポリエチレンテレフテレート等のプラスチック、ガラス、二酸化珪素、酸化アルミニウム、二酸化ジルコニウム、二酸化チタン等の金属酸化物、チタン酸バリウム 等の複酸化物等が挙げられる。特に、比誘電率10以上 (25℃環境下)の固体誘電体を介在させておくことが 低電圧で高速にコロナ処理を行えるという点で有利である。上記比誘電率10以上の固体誘電体としては、例えば、二酸化ジルコニウム、二酸化チタン等の金属酸化物、チタン酸バリウム等の複酸化物等が挙げられる。

【0009】上記二酸化チタンは強誘電体として知られており、二酸化チタン単独組成の場合、結晶構造で比誘電率が異なり、ルチル型結晶構造で比誘電率80程度である。また、Ba、Sr、Pb、Ca、Mg、Zr等の金属の酸化物から選ばれた少なくとも1種以上と二酸化チタンとの混合組成によって、比誘電率は約2000~18500である誘電体が得られ、比誘電率は純度や結晶性によって変えることが出来る。また、二酸化チタン単独では加熱環境下における組成変化が激しく、使用環境が制限されたり、電極上に皮膜として形成する場合の取扱が困難であるため、二酸化チタン5~50重量%、酸化アルミニウム50~95重量%からなる混合物となし、熱的安定性を改良して用いるとよい。

【0010】上記酸化ジルコニウムは、単独の場合、比 誘電率は約12程度であり、低い電圧で放電ブラズマを発生させるのに有利である。通常、酸化ジルコニウムは酸化イットリウム(Y,O,)、炭酸カルシウム(CaCO,)、酸化マグネシウム(MgO)等を30重量%以内で添加して、結晶変態による膨張、収縮を防止し安定化されているが、との様な添加物が添加されていてもよい。比誘電率は、添加物の種類や金属酸化物の結晶性によって決定されるが、少なくとも70重量%は酸化ジルコニウムであるもので好ましい。例えば、酸化イットリウムが4~20重量%添加された酸化ジルコニウム被 腹は比誘電率が8~16程度となるため好ましい。

【0011】上記固体誘電体の厚みは、処理される基材の厚みや印加電圧によって適宜決定されるが、0.01~4mmであることが好ましい。厚すぎるとコロナ放電を発生するのに高電圧を要し、薄すぎると電圧印加時に絶縁破壊が起こりアーク放電が発生するためである。

【0012】上記固体誘電体を被膜として用いる場合、被膜の厚みは、薄い方が低電圧でコロナ放電が発生しやすいが、薄すぎると絶縁破壊してアーク放電が生じやすく、厚すぎると誘電損失が大きくなり放電プラズマが発生し難く、かつ高温度になったり、被膜にクラックが生 10 じたりするため、10~2000μmの間が好ましく、500~1500μmがより好ましい。金属酸化物被膜の厚みは、出来るだけ均一にした方が、コロナ放電処理が安定する。

【0013】放電電極は、コロナ放電処理で用いられる公知の形状の電極構造が用いられる。例えば、薄板状、ナイフエッジ状、ブラシ状等が挙げられ、材質は、対向電極と同様である。

【0014】上記電極間の距離は、基材の厚み、固体誘電体の厚さ、印加電圧の大きさ等を考慮して決定されるが、 $1\sim50$ mmであることが好ましい。1 mm未満では、電極間の間隔を置いて設置するのに充分でない。5 0 mmを超えると、印加電圧が大きくなり、その為に電源も大きくなってしまう。

【0015】図1にバルス電圧波形の例を示す。波形(a)(b)はインバルス型、波形(c)は方形波型の波形である。図1には電圧印加が正負の繰り返しであるものを挙げたが、正又は負のいずれかの極性側に電圧を印加する片波状の波形を用いても良い。

【0016】本発明におけるバルス電圧波形は、とこに挙げた波形に限定されないが、バルスの立ち上がり時間が短いほどストリーマー状の放電が少なく基材へのダメージが少ないため、発泡体基材や凹凸表面基材の処理に有利である。本発明においては、電圧立ち上がり時間は100μs以下であることが必要である。100μs以上では放電を実現するために高電圧を要するため、結果的にアーク放電が発生しやすくなる。より好ましくは、50ns~5μsの範囲である。尚、とこでいう立ち上がり時間とは、電圧変化が連続して正である時間を指す ムのとする

【0017】また、パルス電界の立ち下がり時間も急峻であることが好ましく、立ち上がり時間と同様に100μs以下であることが好ましい。パルス電界発生技術によっても異なるが、例えば、本発明の実施例で使用した電源装置では、立ち上がり時間と立ち下がり時間を同じ時間に設定できる。

【0018】パルス電界の周波数は1kHz~100kHzであることが必要である。1kHz未満であると実用レベルの高速処理が達成されず、100kHz以上では、アーク放電に移行しやすく処理が安定しなくなる。

より好ましくは、5kHz以上であり、このような髙周波数の電界を印加することにより処理速度を大きく向上させることができる。

 $\{0019\}$ また、上記パルス電界におけるパルス継続時間は、 $1\sim1000\mu$ s であることが必要である。 1μ s 未満であると放電が安定しなくなり、 1000μ s を超えるとアーク放電に移行しやすくなる。好ましくは、 3μ s $\sim200\mu$ s である。とこで、パルス継続時間とは、図2中に例を示してあるが、ON、OFFの繰り返しからなるパルス電界における、パルスが連続する時間をいう。図2(a)のような間欠型パルスでは、パルス継続時間はパルス幅時間と等しいが、図2(b)のような波形のパルスでは、パルス幅時間とは異なる。

[0020] さらに、放電を安定させるためには、放電 時間 1 m s 内に、少なくとも $1 \mu \text{ s}$ 継続する 0 f f 時間 を有することが好ましい。

【0021】上記放電は電圧の印加によって行われる。電圧の大きさは基材種及びその厚みや用いる固体誘電体の種類によって適宜決められるが、電界強度 $1\sim100$ kV/cmとなる範囲であることが必要である。1 kV/cm未満であると実用レベルの高速処理が行えなくなり、100 kV/cmを超えるとアーク放電が発生しやすくなる。また、上記電圧は直流が重畳されていても構わない。

【0022】さらに、パルス波形、立ち上がり時間/立ち下がり時間、周波数の異なるパルスを用いて変調を行っても良い。特に、上述したような高速、高周波数のパルス電界に対して、周波数が50~500Hzであり、かつ、デューティー比が20~70%であるパルス電界のはよって変調を行うことにより、低融点基材、発泡体基材、表面に凹凸を有する基材など均一な処理の難しい処理においても、基材損傷を防止し、安定した処理を行うことが出来る。

【0023】本発明2のコロナ放電処理方法は、上記変調を利用したものであり、電圧立ち上がり時間が100 μs以下、パルス継続時間が1~1000μs、周波数0.5~100kHzの基本パルス電界を、周波数が50~500Hzであり、かつ、デューティー比が20~70%であるパルス電界で変調した、平均電界強度が1~100kV/cmの高電圧パルス電界によりコロナ放電を発生させることを特徴とする。

【0024】上記基本バルス電界の波形、電圧立ち上がり時間、バルス継続時間、周波数は本発明1と同様である。変調を行う側のバルス電界は、周波数が50~500Hzであることが必要である。50Hz未満であると低融点基材等の損傷防止効果が期待できず、500Hzを超えると処理スピードが下がる原因となる。また、変調を行う側のバルス電界のデューティー比は、20~70%である必要がある。20%未満であると処理スピー50ドが下がる原因となり、70%を超えると低融点基材等

の損傷防止効果が期待できなくなる。

【0025】本発明3は、本発明1又は2のコロナ放電 処理方法における高電圧パルス電界を、高電圧直流を供 給可能な直流電圧供給部、並びに、ターンオン時間及び ターンオフ時間が500ns以下である半導体素子によ り当該高電圧直流を高電圧パルスに変換するパルス制御 部、から構成される高電圧パルス電源により印加すると とを特徴とする。

【0026】図3は高電圧パルス電源の等価回路図であ り、ターンオンとターンオフが500ns以下の半導体 10 素子をスイッチとして用いて、髙電圧直流を超高速の交 流パルス信号に制御する方式の一例である。原理を簡単 に説明する。+Eは、正極性の高圧直流電源、-Eは負 極性の高圧電源であり、図3の回路に供給される。

【0027】まず、スイッチング素子SW1がONにな ると、電流 11は、図3に示すように流れ負荷を正極性 に充電する。次に、SW1がOFFとなってからSW2 を瞬時にONにする。その結果、負荷に充電した電荷分 は、SW2とダイオードD4を通ってI3の方向に充電 される。その次に、SW2がOFFとなってからSW3 をONにする。その結果、図3の様に I 2 の方向に電流 が流れ、負荷は逆極性に充電される。又、その次にSW 3がOFFになってからSW4を瞬時ONにする。その 結果、負荷に充電した電荷分は、SW4とD2を通って [4の方向に放電する。上述の動作を繰り返すことによ り(表1に動作表を示す)、図4の様な出力パルスが得 られる。

[0028]

【表1】

	0	②	(3)	④	⑤
SW1	OFF	ON	OFF	OFF	OFF
SW2	OFF	OFF	ON	OFF	OFF
SW3	OFF	OFF	OFF	ON	OFF
SW4	OFF	OFF	OFF	OFF	ON

【0029】との回路の利点は、負荷のインピーダンス が非常に高くても、負荷に充電した電荷分をSW2とD 4、SW4とD2を動作させることにより、確実に放電 出来ることと、充電時に於いてもSW1、SW3を使い. 高速に負荷に充電させることが可能である。つまり、S 40 は、AND回路22、23にそれぞれ入力され、他方で W1~4を高速の半導体スイッチング素子を用い、各各 のS♥自体をシリーズに接続して図3の様な回路構成で スイッチング動作させることにより高圧の超高速交流パ ルス信号を出力することが達成可能である。

【0030】以上の電源回路によって構成されたスイッ チングインバーター回路1を備えた高電圧パルス電源の 全体回路構成を図5に示す。この高電圧電源は、上述し たようなスイッチング案子によって構成されたスイッチ ングインバーター回路 1 において正のパルス信号と負の パルス信号とを交互に周期的に生成し、これを昇圧トラ 50 にすると、OR回路20の一方がスイッチによってハイ

ンス2で昇圧してから負荷である例えば除電器の放電電 極3に、正負交互の高電圧として印加するものである。 スイッチングインバータ回路1の前段には、それから出 力されるパルス信号の正負それぞれの電圧を調整する正 電圧調整部4及び負電圧調整部5、周波数を調整する周 波数調整部6、パルス幅を調整するパルス幅調整部7、 変調部8等が設けられている。

【0031】まず、正電圧調整部4は、正電圧発生回路 9から出力される正の直流電圧を電圧設定器 10 により 任意に設定でき、また負電圧調整部5は、負電圧発生回 路11から出力される負の直流電圧を電圧設定器12に より任意に設定できるようになっている。これら正負の 直流電圧はスイッチングインバータ回路1に入力され、 とのスイッチングインバータ回路1が正電圧発生回路9 側に切り替わったときは、正のパルス信号がスイッチン グインバータ1から出力され、負電圧発生回路11側に 切り替わったときは、負のパルス信号がスイッチングイ ンバータ回路1から出力される。

【0032】周波数調整部6は、外部からの制御用の信 20 号の電圧を周波数に変換する電圧/周波数変換回路13 に、スイッチ14を介して周波数調整器(可変抵抗)1 5を接続し、個の周波数調整器15をRとするCR発信 回路の原理により、例えば0~10Vの電圧の外部信号 を例えば50~500Hzの周波数に変換できるように なっている。

【0033】パルス幅調整部7は、周波数調整部6から の出力バルスのバルス幅(時間幅)をバルス幅調整器 1 6による電圧調整機能によって、パルス幅制御回路17 で可変する。その方法としては、差動増幅器を使用し、 30 その基準入力電圧に対して、もう一方の入力電圧を可変 させるとパルス幅が変化する等の方法がある。パルス幅 制御回路17の一対の出力端子からは、バルス幅調整さ れたバルス信号が交互に出力される。

【0034】変調部8は、パルス幅変調部7から出力さ れるパルス信号に対して、変調を与えるか否かを変調用 スイッチ18により選択できるように、OR回路19と OR回路20とクロック発振回路21とAND回路2 2、23とで構成されている。パルス幅制御回路17の 一対の出力端子から出力されたパルス信号は、一方で は、OR回路19によって一つに合流されてクロック発 振回路21へ入力される。変調用スイッチ18は、アー スに接続されているため、これをONにしたときには、 OR回路20はクロック発振回路21からのクロック信 号を出力し、AND回路22、23に入力する。AND 回路22、23のもう一方の入力は、パルス制御回路1 7からの一対の出力が入力し、AND回路22、23の 出力は、パルス幅制御回路17からのパルス幅内にクロ ックが変調した信号となる。変調スイッチ18をOFF

レベルになるので、もう一方のクロック信号は無関係となり、OR回路20の出力はハイレベルとなった状態でAND回路22、23のもう一方の入力はパルス幅制御回路17からの信号が入力するので、との場合は、クロック信号からの変調は受けず、パルス幅制御回路17からの信号のみがAND回路22、23の出力となる。

[0035] 起動・停止回路24はAC100V又は2 のが 00Vの商用交流電源を供給されるシーケンス回路25 により制御されるとともに、正電圧発振回路9及び負電 10 た。
圧発生回路11における過電流を検出する過電流検出回 路26によっても制御される。そして、OR回路22、 23において変調されたバルス信号又は変調されないパルス信号は、起動・停止回路24が停止状態になっていないときにスイッチングインバータ回路1へ入力され、空間であるにスイッチングインバータ回路1内のスイッチング半 導体素子をスイッチングする。一方、昇圧トランス2から電極3に印加される正負の高電圧の変化はモニタ回路 上に 27で監視され、正負それぞれの電圧表示部28、29 によって表示される。 20 0×

【0036】本発明のコロナ放電処理を施される基材としては、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリスチレン、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、ポリテトレフルオロエチレン、アクリル樹脂等のプラスチックやそれらの発泡体、ガラス、セラミック等が挙げられる。また、金属や半導体等の導電性の基材等が挙げられる。基材の形状としては、板状、フィルム状等のものが挙げられるが特にこれらに限定されない。本発明のコロナ放電処理方法は適用可能な基材が広範に渡っていることが特徴であり、電極間に挿入可能な基材であれば30容易に対応することができる。

【0037】図6に、本発明のコロナ放電処理方法を行う装置の一例を示す。この装置に於いては、ワイヤー状の放電電極101と固体誘電体102が設置された対向電極103との間にコロナ放電が発生する。本発明においては、発生したコロナ放電に接触した部位が処理されるので、図6では基材1044の上面が処理される。本装置は、前記の基材104をコロナ放電部に搬送するために、走行ロール105a,105b公知の基材搬送系

105が併設されている。

[0038]

【発明の実施の形態】以下の実施例では、図3の等価回路図による電源(ハイデン研究所社製、半導体素子: IXYS社製、型番IXBH40N160を使用)を用いた。尚、得られたコロナ処理品については、処理直後の接触角を測定した。との時の接触角測定方法は、2μmの水滴を滴下し、協和界面科学社製の接触角測定装置(商品名CA-X150)を用いて静的接触角を測定した。

8

【0039】(実施例1)図6の装置において、放電電 極1 (ステンレスSUS304製、長さ350mm×Φ 1mm)と対向電極3 (ステンレスSUS304製、幅 400mm×長さ300mm) の電極間距離10mmの 空間中の対向電極上に、固体誘電体2としてポリテトラ フルオロエチレン(PTFE、幅400mm×長さ30 0mm)を対向電極3を完全に覆うように設置し、この 上にガラス繊維強化発泡ウレタン基材(積水化学工業 (株) 製:ネオランバーFFU、幅300×長さ100 20 0×厚み3mm)を配置した。電極間に周波数8kH z、立ち上がり速度500nsec、ピークーピーク電 圧16kVの図1(a)のインバルス型波形の高電圧バ ルス電界を印加したととろ、ストリマー放電の極めて少 ないコロナ放電が発生した。コロナ放電を維持させた状 態で基材を線速度10m/分で走行させることによりコ ロナ放電処理を行った。得られた表面処理品を用いて、 上記した測定法に基づき、処理直後の接触角を評価し た。さらに、表面処理面に、枕木用で使用されているウ レタン塗料を塗布し、充分乾燥させた後、JIS K5 400に記載の碁盤目テープ法により密着性を評価し た。評価は、3点で行い、それぞれの評価得点とその平 均値を求めた。また、ブランクとして、未処理品につい ても、接触角評価と碁盤目テープ法を実施した。

【0040】(実施例2~4)周波数、立ち上がり速度、電圧を表2に示したように変えたこと以外は実施例1と同様にインパルス型波形の高電圧パルス電界を印加することによりコロナ放電処理を行い、評価した。

[0041]

【表2】

10

	パルス電界				評 価		
	電圧 k V	周波数 k H z	立ち上り時間 ル S	/// 幅 μs	接触角 (度)	剝離試験 評価点数	
実施例1	1 6	8	0.5	5	25.1	9.33	
実施例 2	1 8	1 5	1	1 0	29.4	9. 00	
実施例3	2 0	1 0	5	3 0	31.8	8.67	
実施例 4	2 5	8	1 0	100	33.3	8.33	
実施例 5	1 4	1 8	0.5	5	23.7	9.33	
比較例1	3 0	3 0	siı	1	基材損傷		
比較例 2	1 6	0.5	0.5	5	61.2	3.67	
未処理品					98.2	0	

【0042】(実施例5)固体誘電体として、PTFE の代わりに、対向電極全面に酸化チタン13%、酸化アルミニウム87%からなる1.5mm厚みの溶射法コー 20ティングした被膜を用い、周波数、立ち上がり速度、電圧を表2に示したように変えたこと以外は実施例1と同様に行った。

【0043】(比較例1)高電圧パルス電界に代えて、周波数30kHz、ピークーピーク電圧30kVの連続 sin波の交流電界を印加したこと以外は実施例1と同様にして、ガラス繊維強化発泡ウレタン基材に処理を施した。コロナ放電中にストリーマーが多く観察され、基材には貫通孔等の損傷が観察され良好な処理結果は得られなかった。

[0044] (比較例2) 実施例1で周波数を0.5k*

* H z にした以外は同様である。実施例1と比較すると、 処理効果が不十分であることが、明白である。

0 【0045】(実施例6)基材として電子線架橋高発泡ポリエチレン基材(積水化学工業株式会社製:ソフトロン、大きさ:150×300mm、厚み2mm)を用い、電極間に周波数8kHz、立ち上がり速度500nsec、ピークーピーク電圧16kVの基本バルス電界を、周波数135Hz、デューティ比43%のバルス電界により変調を行ったパルス電界を5秒間印加することによりコロナ放電を発生させたこと以外は実施例1と同様に行った。図7に変調後のパルス電界の波形を示す。接触角の評価結果を表3に示す。

30 【0046】 : 【表3】

	基本パルス電界			変調パルス電界		評価	
	電圧 kV	周波数 k H z	立ち上り時間 μs	仏 λ 幅 μ s	周波数 H z	デュ - ティ比 %	接触角(度)
実施例 6	1 6	8	0. 5	5	1 3 5	4 3	5 3 . 6
実施例了	1 6	8	0. 5	5	3 1 0	4 3	5 T. 2
比較例 3	3 0	3 0	s	i n			基材損傷
未処理品	_						98.2

【0047】(実施例7)周波数310Hzのパルス電界により変調した以外は、実施例6と同様に行った。接触角の評価結果を表3に示す。

【0048】(比較例3)高電圧パルス電界に代えて、周波数30kHz、ビークーピーク電圧30kVの連続 sin波の交流電界を印加したこと以外は実施例1と同様にして、電子線架橋高発泡ポリエチレン基材に処理を施した。コロナ放電中にストリーマーが多く観察され、

基材には貫通孔等の損傷が観察され良好な処理結果は得 られなかった。

[0049]

【発明の効果】本発明は、低融点基材、導電性の高い基材、発泡体、凹凸表面を有する基材、フッ素系樹脂等の基材に対しても安定したコロナ放電処理を行うことが出来る。また、従来のコロナ放電処理と比較して、非常に50 効率の高い処理を行うことが出来る。

12

【図面の簡単な説明】

本発明の高電圧パルス電界におけるパルス波 【図1】 形の例

11

本発明の高電圧パルス電界におけるパルス継 【図2】 続時間の説明図

本発明の高電圧パルス電源の等価回路図 【図3】

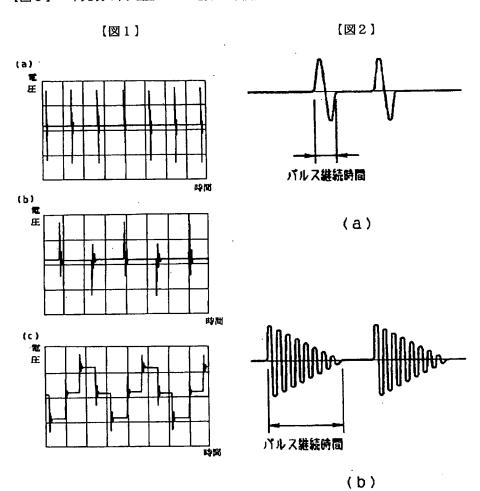
本発明の高電圧パルス電源のパルス出力図 *【図4】

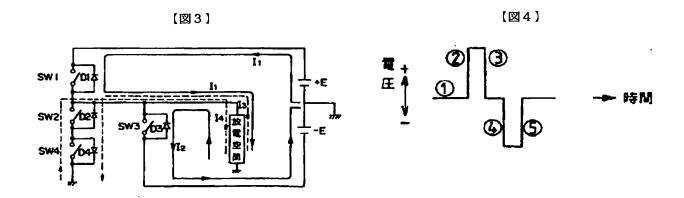
本発明の高電圧パルス電源の全体回路構成図 【図5】

本発明のコロナ放電処理装置の一例 【図6】

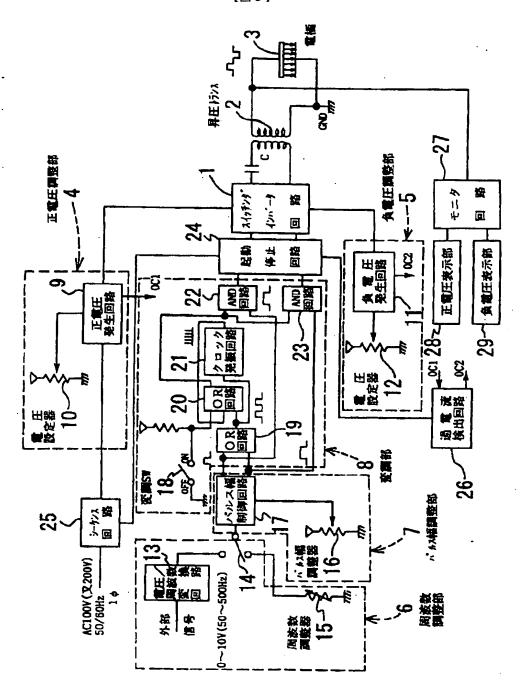
実施例6の変調された高電圧パルス電界の波 【図7】 形図

*

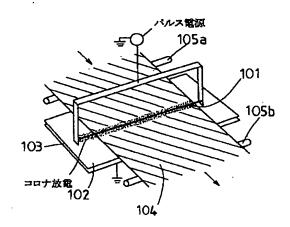




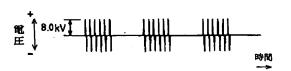
【図5】



【図6】



【図7】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

FΙ

B 2 9 L 7:00